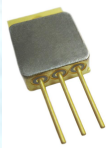




ОАО «ИНТЕГРАЛ» филиал «ТРАНЗИСТОР»

Новые разработки
изделий спецназначения

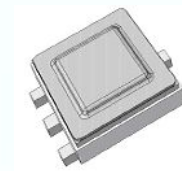
ИЗДЕЛИЯ С ПРИЕМКОЙ ЗАКАЗЧИКА, ОСВАИВАЕМЫЕ В 2010 г.

№ п/п	Обозначение прибора (корпусное исполнение)	Функциональное назначение	Обозначение ТУ	Тип корпуса
1	Серия 1264	Стабилизаторы напряжения положительной полярности на токи нагрузки до 7А: регулируемый на 1.25 В и с фиксированным выходным напряжением 1,25 В; 2,5 В; 2,85В; 3,3 В ; 5 В; 9 В; 12 В	АЕЯР.431420.352 ТУ	КТ-97В 
2	142ЕР1ТИМ	Регулируемый стабилизатор напряжения положительной полярности параллельного типа: опорное напряжение 2,495В и диапазон регулировки до 30 В	АЕЯР.431420.365 ТУ, АЕЯР.431420.365-01 ТУ	4601.3 

**НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В РАЗРАБОТКЕ
2010г.**

2П524А9 , 2П524А-5 , АЕЯР.432140.519ТУ n-канальный МОП полевой транзистор

Кремниевый эпитаксиально-планарный полевой переключательный транзистор с изолированным затвором, логическим уровнем управления, обогащением n-канала и встроенным обратносмещенным диодом
Корпусное исполнение КТ-99-1, возможность поставок бескорпусного варианта



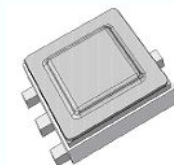
Значения характеристик:

7И1 по группе исполнения 3Ус, 7И6 - 4Ус, 7И7 – 4x4Ус, 7И8 - 2 x 10Е-5 x 1Ус, 7С1 - 5x4Ус, 7С4 - 1Ус, 7К1 – 5x1К, 7К4 - 0,5x1К ГОСТ РВ 20.39.414.2

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Предельная норма
Максимально допустимый постоянный ток стока, А при $T_{ср} = 25\text{ °C}$	$I_{с.мах}$	1,4
Максимально допустимый постоянный ток стока, А при $T_{ср} = 100\text{ °C}$	$I_{с.мах}$	0,4
Максимально допустимый импульсный ток стока, А	$I_{с(и) мах}$	2,8
Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, А	$I_{пр.мах}$	1,4
Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, А	$I_{пр.(и) мах}$	2,8
Максимально допустимое напряжение сток-исток, В	$U_{си.мах}$	50
Максимально допустимое напряжение затвор-исток, В	$U_{зи.мах}$	± 10
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт при $T_{ср} = 25\text{ °C}$	$P_{мах}$	1,0
Максимально допустимая температура перехода, °C	$T_{п.мах}$	150
Тепловое сопротивление переход-среда, °C/Вт	$R_{т пс}$	125

ОКР «Титул» n-канальный МОП полевой транзистор

Кремниевый эпитаксиально-планарный полевой транзистор с изолированным затвором, логическим уровнем управления, обогащением n-канала и встроенным обратносмещенным диодом. Повышенная стойкость к СВВФ
 Корпусное исполнение КТ-99-1, возможность поставок бескорпусного варианта

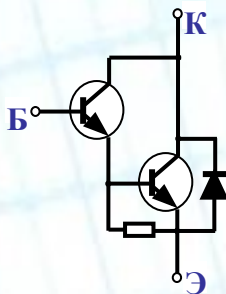


Значения характеристик:

**7И1 - 0,5 x 5Ус , 7И6 - 4Ус, 7И7 – 0,5 x 6Ус , 7И8 - 2 x 10 Е-5 x 1Ус , 7С1 - 50 x 5Ус , 7С4 - 5 x 4Ус ,
 7К1 – 2К , 7К4 - 1К ГОСТ РВ 20.39.414.2**

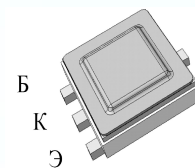
Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Предельная норма
Максимально допустимый постоянный ток стока, А при $T_{ср} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	$I_{с.мах}$	1,4
Максимально допустимый постоянный ток стока, А при $T_{ср} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	$I_{с.мах}$	0,52
Максимально допустимый импульсный ток стока, А	$I_{с(и) мах}$	2,28
Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, А	$I_{пр.мах}$	1,14
Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, А	$I_{пр.(и) мах}$	2,28
Максимально допустимое напряжение сток-исток, В	$U_{си.мах}$	100
Максимально допустимое напряжение затвор-исток, В	$U_{зи.мах}$	± 10
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт при $T_{ср} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	$P_{мах}$	3,0
Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	$T_{п.мах}$	150
Тепловое сопротивление переход-среда, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{т пс}$	125

2ТД543А9, АЕЯР.432150.538ТУ, Составной биполярный n-p-n транзистор



Кремниевый эпитаксиально-планарный биполярный
составной транзистор

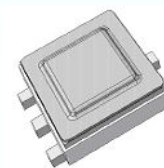
Корпусное исполнение КТ-99-1



Наименование параметра, единица измерения (режим и условия измерения)	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимая норма при эксплуатации
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В ($U_{ЭБ} = 0$)	$U_{КЭК} \max$	80
Максимально допустимое постоянное напряжение база-эмиттер, В	$U_{ЭБ} \max$	5
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{К} \max$	1,0
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А ($t_{ИМП} = 6,3 \text{ мс}$, $Q \geq 2$)	$I_{К \text{ имп}} \max$	2,0
Максимально допустимый постоянный ток базы, мА	$I_{Б} \max$	100
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт $T_{ср} = (-60)^{\circ}\text{C} - (+25)$	$P_{К} \max$	0,8
Тепловое сопротивление переход-среда, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\Theta \text{ ПЕР-СР}}$	156
Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	$T_{ПЕР} \max$	150

ОКР «Транзистор-М» Составной биполярный n-p-n транзистор

Кремниевый эпитаксиально-планарный
биполярный составной транзистор Дарлингтона
Корпусное исполнение КТ-99-1



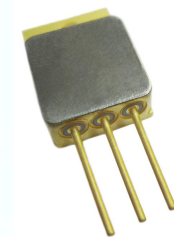
Значения характеристик:

7И1 - 0,5 x 5Ус , 7И6 - 4Ус, 7И7 – 0,5 x 6Ус , 7И8 - 2 x 10 Е-5 x 1Ус , 7С1 - 50 x 5Ус , 7С4 - 5 x 4Ус ,
7К1 – 2К , 7К4 - 1К ГОСТ РВ 20.39.414.2

Наименование параметра, единица измерения (режим и условия измерения)	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимая норма при эксплуатации
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В (UЭБ = 0)	UкЭК max	80
Максимально допустимое постоянное напряжение база-эмиттер, В	UЭБ max	5
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	Iк max	2,0
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А (tИМП =6,3 мс, Q ≥ 2)	Iк имп max	4,0
Максимально допустимый постоянный ток базы, мА	IБ max	100
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт Tср = (-60)°С – (+25)	Рк max	5,0
Максимально допустимая температура перехода, °С	TПЕР max	150

ОКР «Трактат», полевой транзистор (ближайший аналог КП723Г)

Кремниевый эпитаксиально-планарный полевой переключательный транзистор с изолированным затвором, обогащением n-канала, логическим уровнем управления и встроенным обратносмещенным диодом, с повышенной стойкостью с СВВФ
Корпусное исполнение: металлокерамический корпус ТО-254



Значения характеристик:

7И1 по группе исполнения 3Ус, 7И6 - 4Ус, 7И7 - 4Ус, 7И8 - 2 x 10 E-5 x 1Ус, 7С1 - 4Ус, 7С4 - 4Ус, 7К1 - 5x1.К, 7К4 - 0,5x1.К ГОСТ РВ 20.39.414.2

Предельно-допустимые режимы эксплуатации

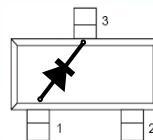
Наименование параметра, единица измерения (режим и условия измерений)	Обозначение	Предельное значение
Максимально допустимый постоянный ток стока, А при $T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{с.мах}$	50
Максимально допустимый постоянный ток стока, А при $T_{корп} = 125^{\circ}\text{C}$	$I_{с.мах}$	29
Максимально допустимый импульсный ток стока, А	$I_{с.(и) мах}$	200
Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, А	$I_{пр.мах}$	50
Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, А	$I_{пр.(и) мах}$	200
Максимально допустимое напряжение сток-исток, В	$U_{си.мах}$	60
Максимально допустимое напряжение затвор-исток, В	$U_{зи.мах}$	± 10
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт	$P_{мах}$	150
Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	$T_{п.мах}$	175
Тепловое сопротивление переход-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{т пк}$	1,0

СВЧ диод Шоттки 2ДШ142А9 набор СВЧ диодов Шоттки 2ДШ142АС9

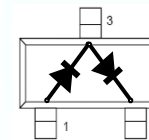
Функциональное назначение диодов

использование в импульсных устройствах, преобразователях высокочастотного напряжения, детекторах и других узлах и блоках аппаратуры специального назначения.

Корпусное исполнение: малогабаритный пластмассовый корпус для поверхностного монтажа КТ-46А



Один диод в корпусе



Набор диодов
(два последовательно соединённых диода)

**Значения электрических параметров диодов при приемке (поставке), эксплуатации
(в течение наработки) и хранения (в течение срока сохраняемости) [T_{ср} = (25 ± 10) °С]**

Измеряемые параметры		Н о р м а		Режим измерения
Наименование, ед. изм.	Обозначение	не менее	не более	
Обратный ток диода, мкА	I _{ОБР}	–	0,5	U _{ОБР} = 15 В
Прямое напряжение диода*, В	U _{ПР}	–	0,4	I _{ПР} = 1,0 мА
Прямое напряжение диода*, В	U _{ПР}	–	1,1	I _{ПР} = 50,0 мА
Ёмкость диода, пФ	C _д	–	2,0	U _{ОБР} = 0 В, f = 1МГц

* Длительность импульса при измерениях (t_{ИМП}) не более 2 мс, Q ≥ 50

Предельно-допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения (режим и условия измерений)	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимая норма при эксплуатации
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В	$U_{\text{ОБР макс}}$	18
Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В	$U_{\text{ОБР И макс}}$	18
Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, мА	$I_{\text{ПР макс}}$	50
Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, мА ($t_{\text{ИМП}} = 6,3 \text{ мс}, Q > 2$)	$I_{\text{ПР И макс}}$	100

Значения характеристик специальных факторов

во время и непосредственно после воздействия которых диод должен выполнять свои функции

Вид специальных факторов	Характеристики специальных факторов	Значения характеристик специальных факторов
7.И	$7.И_1$	$1Y_c$
	$7.И_6$	$2Y_c$
	$7.И_7$	$5 \times 2Y_c$
	$7.И_8$	$10^{-5} \times 1Y_c$
7.С	$7.С_1$	$1Y_c$
	$7.С_4$	$1Y_c$
7.К	$7.К_1$	1К
	$7.К_4$	$0,1 \times 1К$

Контактные телефоны филиала «Транзистор»:

Отдел маркетинга и внешних связей (10-375-017) 212 59 32

Главный конструктор (10-375-017) 212 41 21

Конструкторско-технологический отдел (10-375-017) 278 67 52

(10-375-017) 278 05 14